



**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation 6:</b> <b>H05K 3/18, C23C 18/16, 18/20</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:</b> <b>WO 99/05895</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 4. Februar 1999 (04.02.99)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP98/04413 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 16. Juli 1998 (16.07.98)  <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 197 31 346.9      22. Juli 1997 (22.07.97)      DE  <b>(71)(72) Anmelder und Erfinder:</b> NAUNDORF, Gerhard [DE/DE]; Auf der Balsterhöhe 9a, D-32657 Lemgo (DE). WISSBROCK, Horst [DE/DE]; Richard-Wagner-Strasse 7a, D-32657 Lemgo (DE).  <b>(74) Anwälte:</b> BRAUN, Dieter, Hagemann, Braun & Held, Hildesheimer Strasse 133, D-30173 Hannover (DE) usw.		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
<b>(54) Title:</b> CONDUCTING PATH STRUCTURES SITUATED ON A NON-CONDUCTIVE SUPPORT MATERIAL, ESPECIALLY FINE CONDUCTING PATH STRUCTURES AND METHOD FOR PRODUCING SAME		
<b>(54) Bezeichnung:</b> LEITERBAHNSTRUKTUREN AUF EINEM NICHTLEITENDEN TRÄGERMATERIAL, INSBESONDERE FEINE LEITERBAHNSTRUKTUREN UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG		
<b>(57) Abstract</b>		
<p>The invention relates to conducting path structures situated on a non-conductive support material, especially fine conducting path structures consisting of a base containing a heavy metal and a metallization layer applied to said base. The invention also relates to a method for producing said structures. The invention is characterized in that the heavy-metal containing base contains heavy metal nuclei in the area of the conducting path structures, which nuclei were formed by the rupture of an organic, non-conductive heavy metal complex, and that the support material contains microporous or microrough carrier particles to which the heavy metal nuclei are bonded. This achieves excellent adhesion of the deposited metallic conducting paths. This method is suited in particular also for producing three-dimensional circuit supports.</p>		
<b>(57) Zusammenfassung</b>		
<p>Beschrieben werden Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial, insbesondere feine Leiterbahnstrukturen, die aus einer schwermetallhaltigen Basis und einer auf diese aufgetragenen Metallisierungsschicht bestehen und ein Verfahren zu deren Herstellung. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die schwermetallhaltige Basis im Bereich der Leiterbahnstrukturen Schwermetallkeime enthält, die durch Aufbrechen eines organischen nichtleitenden Schwermetallkomplexes entstanden sind und daß das Trägermaterial mikroporöse oder mikrorauhe Trägerpartikel enthält, an die die Schwermetallkeime gebunden sind. Es wird eine hervorragende Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzielt. Das Verfahren ist insbesondere auch zur Herstellung von dreidimensionalen Schaltungsträgern geeignet.</p>		

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

**Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial, insbesondere feine  
Leiterbahnstrukturen und Verfahren zu ihrer Herstellung**

Die Erfindung betrifft Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial, insbesondere feine Leiterbahnstrukturen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein  
5 Verfahren zur Herstellung der Leiterbahnstrukturen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 8.

Durch den Sonderdruck "LAD - Ein neuartiges lasergestütztes Beschichtungsverfahren für Feinstleitermetallisierungen" aus Heft Nummer 10, Band 81 (1990) der Fachzeitschrift  
10 "Galvanotechnik" ist es bekannt geworden, zur Herstellung von Feinstleiterstrukturen von deutlich unter 100 nm auf einem nichtleitenden Trägermaterial vollflächig Pd-Acetat aus einer Lösung als dünnen Film aufzubringen. Durch eine nachfolgende Laserbelichtung mittels eines Excimerlasers mit einer Wellenlänge von 248 nm sollen dann im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen Metallatome als Keime für eine nachfolgende stromlose  
15 Metallisierung freigesetzt werden. Vor der Metallisierung ist es jedoch erforderlich, einen Spülprozeß zur Entfernung der unzersetzten Bereiche des auf das Trägermaterial aufgetragenen metallhaltigen Filmes durchzuführen. Der Qualität dieses Spülprozesses kommt dabei eine entscheidende Rolle für die Vermeidung von Wildwuchsproblemen bei der nachfolgenden stromlosen Metallisierung zu. Im übrigen hat es sich gezeigt, daß mittels des

beschriebenen Verfahrens keine ausreichende Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzieltbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, einfach und sicher herzustellende feine Leiterbahnstrukturen elektrischer Schaltungen, insbesondere auch auf räumlichen Schaltungsträgern, zur Verfügung zu stellen und ferner ein wesentlich vereinfachtes und sicheres Verfahren zur Herstellung der Leiterbahnstrukturen zu schaffen, das volladditiv durch selektive Oberflächenaktivierung und reduktive Kupferabscheidung eine feine Strukturierung ermöglicht.

10

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 8 gelöst. Die weiteren Ausgestaltungen der Erfindung sind den jeweils zugehörigen Unteransprüchen zu entnehmen.

Da die schwermetallhaltige Basis des Trägermaterials im Bereich der Leiterbahnstrukturen Schwermetallkeime enthält, die durch Aufbrechen eines elektrisch nichtleitenden, auf eine mikroporöse Oberfläche des Trägermaterials aufgetragenen organischen Schwermetallkomplexes entstanden sind, kann eine Metallisierung erfolgen, ohne daß es erforderlich ist, um Wildwuchsprobleme zu vermeiden, die unbehandelten Bereiche der schwermetallhaltigen Basis vorher zu entfernen.

Zusätzlich wird eine hervorragende Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzielt, da das Trägermaterial mikroporöse oder mikrorauhe Trägerpartikel enthält, an die die Schwermetallkeime gebunden sind. Bei der Metallisierung wird durch das in die Poren hineinwachsende Kupfer eine feste Verwurzelung erreicht und damit eine optimale Haftung der aufgetragenen Leiterzüge auf dem Schaltungsträger gewährleistet.

Die Zugänglichkeit der haftvermittelnden Mikroporen wird außerdem dadurch erhöht, daß das Trägermaterial aus einer Polymermatrix mit eingebetteten mikroporösen oder mikrorauen Trägerpartikeln für die Schwermetallkeime besteht, die durch die aufgetragene UV-Strahlung zwar an der Oberfläche durch Ablation des Polymeren freigelegt, selbst aber durch die UV-Strahlung nicht abgebaut werden. Danach kann das Werkstück direkt chemisch reduktiv metallisiert werden. Erfindungsgemäß wird somit mit doppelter Wirkung aktiviert, indem einerseits die zur Metallhaftung erforderlichen Mikroporen bzw. Mikrorauhigkeiten freigelegt und andererseits eben dort auch die erforderlichen

Schwermetallkeime durch Aufbrechen des organischen, nichtleitenden Schwermetallkomplexes freigesetzt werden.

Indem gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren als schwermetallhaltige Komponente ein  
5 organischer nichtleitender Schwermetallkomplex an mikroporöse Trägerpartikel angebunden  
wird, die Trägerpartikel im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen in das  
Trägermaterial eingemischt und/oder auf das Trägermaterial aufgebracht und angebunden  
werden werden, auf das Trägermaterial eine elektromagnetische UV-Strahlung im Bereich  
der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen selektiv aufgebracht wird, derart, daß  
10 Trägerpartikel durch Abtrag freigelegt und durch ein Aufbrechen des angebundenen  
Schwermetallkomplexes Schwermetallkeime freigesetzt werden und dieser Bereich zur  
Ausbildung der Leiterbahnstrukturen anschließend chemisch-reduktiv metallisiert wird,  
werden einerseits die zur Metallhaftung erforderlichen Mikroporen bzw. Mikrorauhigkeiten  
freigelegt und andererseits eben dort auch die erforderlichen Schwermetallkeime durch  
15 Aufbrechen des organischen, nichtleitenden Schwermetallkomplexes freigesetzt.

Von Vorteil ist es, daß nach der Einwirkung der elektromagnetischen UV-Strahlung direkt  
anschließend die chemisch reduktive Metallisierung erfolgen kann. Ein durchaus  
problematischer Spülprozeß ist nicht erforderlich. Im Bereich der zu erzeugenden  
20 Leiterbahnstrukturen erfolgt durch die Einwirkung der UV-Strahlung ein Aufbrechen des  
Schwermetallkomplexes, wodurch für die partielle reduktive Metallisierung hochreaktive  
Schwermetallkeime abgespalten werden. Die Metallisierung erfolgt dennoch ohne jeden  
Wildwuchs unter Ausbildung sehr scharfer Konturen. Da die gebildeten Schwermetallkeime  
hochreaktiv sind, wird die erwünschte exakte Metallisierung in der erforderlichen  
25 Schichtdicke zusätzlich begünstigt.

Im Rahmen der Erfindung ist es vorgesehen, daß eine elektromagnetische Strahlung eines  
UV-Lasers, eines Excimer-Lasers oder eines UV-Strahlers eingesetzt wird. Gemäß einer  
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird zur Freilegung der mikroporösen  
30 Füllstoffpartikel und zur Abspaltung der Schwermetallkeime ein KrF-Excimerlaser mit einer  
Wellenlänge von 248 nm eingesetzt.

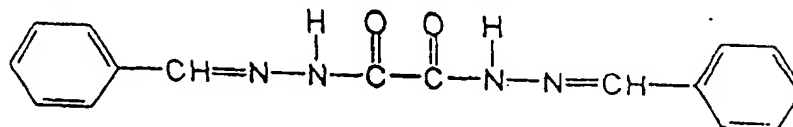
Vorzugsweise wird ein Pd-Komplex bzw. ein Pd-haltiger Schwermetallkomplex verwendet.  
Wie sich gezeigt hat, sind derartige Schwermetallkomplexe besonders gut zur Feinst-  
35 strukturierung gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren geeignet. Insbesondere ist für die

Einleitung der strukturierenden Spaltungsreaktion eine UV-Strahlung einer wesentlich geringeren Energiedichte ausreichend, als für das Abtragen bzw. auch für das Auslösen des als Zersetzung beschriebenen Wirkungsmechanismus bei bekannten Systemen. Zusätzlich wird erreicht, daß im Zusammenhang mit der Strukturierung pro Laserimpuls wesentlich  
5 größere Flächen belichtet werden können als bei bekannten Ablationstechniken.

Im Rahmen der Erfindung ist es außerdem vorgesehen, daß zur Abspaltung der Schwermetallkeime aus dem Schwermetallkomplex vorzugsweise ein Kr F-Excimerlaser mit einer Wellenlänge von 248 nm eingesetzt wird. Es ist so möglich, die Abspaltung ohne  
10 Aufheizung des Komplexes durchzuführen. Hierdurch wird ein Aufschmelzen von Materialien im Einwirkungsbereich vermieden. Die Folge ist eine sehr hohe Begrenzungsschärfe der Bereiche mit abgespalteten Schwermetallkeimen und sich daraus ergebend eine sehr hohe, äußerst vorteilhafte Kantenschärfe der metallisierten Strukturen, was insbesondere bei Feinstleitern von großer Bedeutung ist.

15 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist es außerdem vorgesehen, daß Palladiumdiacetat mit einem organischen Komplexbildner zu einem Pd-Komplex umgesetzt wird. Wie sich gezeigt hat, ist es vorteilhaft, wenn als organischer Komplexbildner ein an sich bekannter, hochstabiler polyfunktioneller Chelatbildner mit mehreren Ligandenatomen,  
20 wie N, O, S, P eingesetzt wird. Im Rahmen der Erfindung ist es weiterhin vorgesehen, daß der polyfunktionelle Chelatbildner auch zusammen mit ionisierenden Gruppen, wie Hydroxyl- oder Carboxylgruppen, eingesetzt werden kann.

Insbesondere können als organische Komplexbildner molekulare Kombinationen von  
25 sterisch gehinderten Aromaten und metallkomplexierenden Gruppen eingesetzt werden. Vorzugsweise findet dabei ein organischer Komplexbildner der Formel



30

Verwendung.

Vorteilhaft ist es, wenn gegen elektromagnetische UV-Strahlung resistente Trägerpartikel als Träger für den Schwermetallkomplex eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich

bevorzugt um anorganisch-mineralische Trägerpartikel, die von pyrogener Kieselsäure oder von Aerogelen gebildet sind.

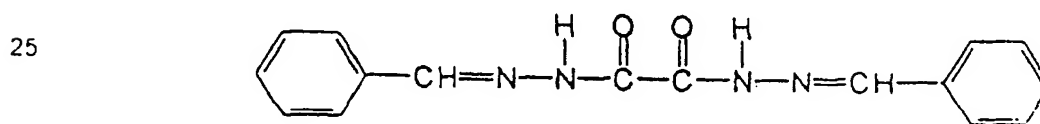
Gemäß bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung sind die Trägerpartikel von  
5 pyrogener Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g oder von Aerogelen gebildet.

Im Rahmen der Erfindung ist es weiterhin vorgesehen, daß das Anbinden des Schwermetallkomplexes an die Trägerpartikel durch Tränken in einer Lösung des Schwermetallkomplexes erfolgt. Die so präparierten Trägerpartikel werden dann in den  
10 Polymerwerkstoff eingemischt, aus denen die Schaltungsträger gespritzt werden. Alternativ ist es vorgesehen, daß die Trägerpartikel mit dem Schwermetallkomplex in ein Bindemittel, insbesondere einen Lack eingemischt und dann als Beschichtung auf das Trägermaterial aufgebracht werden.

15 Das erfindungsgemäße Verfahren kann sowohl mit flächig aufgebrachter Laserstrahlung und Maskentechnik in einer rationellen Massenfertigung eingesetzt werden, als auch maskenlos über eine beispielsweise NC-gesteuerte Führung eines punktförmig fokussierten Laserstrahls zur Prototypen- oder Kleinserienfertigung Anwendung finden.

20 Im folgenden wird die Erfindung an einem Ausführungsbeispiel erläutert:

Es werden 2,24 Masseteile Palladiumdiacetat in 100 Masseteilen Dimethylformamid gelöst. Außerdem werden 2,94 Masseteile des organischen Komplexbildners der Formel



in 800 Masseteile Dimethylformamid eingebracht und durch Erwärmen gelöst. Beide Lösungen werden dann gemischt und zur Reaktion gebracht. Unmittelbar danach, bevor die  
30 Lösung abkühlt und der entstandene Palladiumkomplex ausfällt, werden werden Trägerpartikel, die aus einer pyrogenen Kieselsäure bestehen, die unter der Bezeichnung "Aerosil 200" erhältlich ist, in der Lösung getränkt. Nach einem Trocknungs- und Mahlvorgang werden die Trägerpartikel nach einem gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren in einen Polymerpulveransatz in einem Anteil von bis zu 50% eingemischt. Nach der  
35 Agglomeration des Materials im Heißmischer erfolgt in einem Granulator eine Granulierung

des Materials. Das Kunststoffgranulat enthält nun die erforderliche Menge des organischen Schwermetallkomplexes in der Porenstruktur der eingearbeiteten Trägerpartikel. Das Granulat wird dann mittels der Spritzgießtechnik zu dreidimensionalen Schaltungsträgern verarbeitet.

5

Die Schaltungsträger werden anschließend mittels einer Excimerlaser-UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von 248 nm, über eine Maske bestrahlt. In den bestrahlten Bereichen werden dabei die Trägerpartikel durch Ablation der sie umgebenden Polymermatrix freigelegt und gleichzeitig an und in den Poren der Trägerpartikel feinstverteiltes

10 metallisches Palladium aus dem Schwermetallkomplex abgespalten. In einem handelsüblichen reduktiven, außenstromlosen Kupferbad scheidet sich selektiv in den bestrahlten Bereichen sehr haftfest verankertes Kupfer ab. Die Leiterzüge sind ausgebildet, es liegt ein einsatzfähiger Schaltungsträger vor.

15 Alternativ ist es auch möglich, als Trägerpartikel Aerogele einzusetzen. Die hochporösen Festkörper aus SiO<sub>2</sub> mit einer BET-Oberfläche von bis zu 1000 m<sup>2</sup>/g ermöglichen eine noch festere Anbindung der metallischen Leiterbahnen an den Schaltungsträger.



### Patentansprüche

1. Leiterbahnstrukturen auf einem nichtleitenden Trägermaterial, insbesondere feine Leiterbahnstrukturen, die aus einer schwermetallhaltigen Basis und einer auf diese aufgetragenen Metallisierungsschicht bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß die  
5 schwermetallhaltige Basis im Bereich der Leiterbahnstrukturen Schwermetallkeime enthält, die durch Aufbrechen eines organischen nichtleitenden Schwermetallkomplexes entstanden sind und daß das Trägermaterial mikroporöse oder mikrorauhe Trägerpartikel enthält, an die die Schwermetallkeime gebunden sind.
- 10 2. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial aus einer Polymermatrix mit eingebetteten oder angebundenen mikroporösen oder mikrorauen Trägerpartikeln besteht, an die die Schwermetallkeime gebunden sind.
3. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1 und gegebenenfalls Anspruch 2, dadurch  
15 gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von pyrogener Kieselsäure oder von Aerogelen gebildet sind.
4. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von pyrogener Kieselsäure mit  
20 einer BET-Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g gebildet sind.

5. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von Aerogelen gebildet sind.

5 6. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwermetallkomplex ein Pd-haltiger Schwermetallkomplex ist.

7. Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1 und einem oder mehreren der weiteren  
10 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwermetallkomplex ein Pd-Komplex ist.

8. Verfahren zur Herstellung der Leiterbahnstrukturen nach Anspruch 1, wobei eine schwermetallhaltige Komponente auf ein nichtleitendes Trägermaterial aufgebracht wird, im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen eine elektromagnetische Strahlung im  
15 UV-Bereich selektiv aufgebracht wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt werden und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß

- als schwermetallhaltige Komponente ein organischer nichtleitender Schwermetallkomplex an mikroporöse oder mikrorauhe Trägerpartikel angebunden wird,
- die Trägerpartikel im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen in das  
20 Trägermaterial eingemischt und/oder auf das Trägermaterial aufgebracht und angebunden werden werden,
- auf das Trägermaterial eine elektromagnetische UV-Strahlung im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen selektiv aufgebracht wird, derart, daß Trägerpartikel durch Abtrag freigelegt und durch ein Aufbrechen des angebundenen  
25 Schwermetallkomplexes Schwermetallkeime freigesetzt werden,
- dieser Bereich zur Ausbildung der Leiterbahnstrukturen anschließend chemisch-reduktiv metallisiert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine elektromagnetische  
30 Strahlung eines UV-Lasers, eines Excimer-Lasers oder eines UV-Strahlers eingesetzt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß zur Freilegung der mikroporösen Füllstoffpartikel und zur Abspaltung der Schwermetallkeime ein KrF-Excimerlaser mit einer Wellenlänge von 248 nm eingesetzt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Pd-haltiger Schwermetallkomplex verwendet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß ein Pd-Komplex verwendet  
5 wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Pd-Komplex gebildet wird, indem ein Palladiumsalz mit einem organischen Komplexbildner umgesetzt wird.

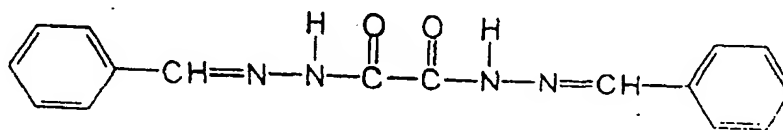
10 14. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Pd-Komplex gebildet wird, indem Palladiumdiacetat mit einem organischen Komplexbildner umgesetzt und auskristallisiert wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß als organischer  
15 Komplexbildner ein hochstabiler polyfunktioneller Chelatbildner mit mehreren Ligandenatomen, wie N, O, S, P allein oder zusammen mit ionisierenden Gruppen, wie Hydroxyl- oder Carboxylgruppen, eingesetzt wird.

16. Verfahren nach den Ansprüchen 14 und 15, dadurch gekennzeichnet, daß als  
20 organischer Komplexbildner molekulare Kombinationen von sterisch gehinderten Aromaten und metallkomplexierenden Gruppen eingesetzt werden.

17. Verfahren nach den Ansprüchen 14, 15 und 16, dadurch gekennzeichnet, daß ein organischer Komplexbildner der Formel

25



eingesetzt wird.

30 18. Verfahren nach Anspruch 8 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß gegen UV-Strahlung resistente Trägerpartikel eingesetzt werden.

19. Verfahren nach Anspruch 8 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß anorganisch-mineralische Trägerpartikel eingesetzt werden.

35

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von pyrogener Kieselsäure oder von Aerogelen gebildet sind.
21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von  
5 pyrogener Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche von  $200 \text{ m}^2/\text{g}$  gebildet sind.
22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel von Aerogelen gebildet sind.
- 10 23. Verfahren nach Anspruch 8 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Anbinden des Schwermetallkomplexes an die Füllstoffpartikel durch Tränken in einer Lösung des Schwermetallkomplexes erfolgt.
24. Verfahren nach Anspruch 8 und einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch  
15 gekennzeichnet, daß die Trägerpartikel mit dem Schwermetallkomplex in ein Bindemittel, insbesondere einen Lack eingemischt und dann als Beschichtung auf das Trägermaterial aufgebracht werden.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In nationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/04413

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 H05K3/18 C23C18/16 C23C18/20

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H05K C23C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 405 656 A (ISHIKAWA ET AL.) 11. April 1995 siehe Ansprüche	1,6-9, 11-13,15
A	EP 0 277 325 A (SIEMENS AG) 10. August 1988 siehe Ansprüche 1-6,9,12-14	1,3,6, 19,20
A	US 3 546 011 A (KNORRE ET AL.) 8. Dezember 1970 siehe Ansprüche	1-4,6, 19-21
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 335 (C-384), 13. November 1986 & JP 61 141774 A (SUMITOMO BAKELITE CO), 28. Juni 1986 siehe Zusammenfassung	1,3,4, 19-21,24
	--- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benützung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindnerischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindnerischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. November 1998

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14/12/1998

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Mes, L

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 328 (E-1385), 22. Juni 1993 & JP 05 037129 A (HITACHI AIC ), 12. Februar 1993 siehe Zusammenfassung -----	1,2, 8-10,19
A	J. GANZ ET AL.: "LAD - Ein neuartiges lasergestütztes Beschichtungsverfahren für Feinstleitermetallisierungen" GALVANOTECHNIK., Bd. 81, Nr. 10, Oktober 1990, Seiten 3661-3668, XP002085825 SAULGAU/WURTT DE in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3662 - Seite 3664 -----	1,6,8-10

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/04413

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5405656	A	11-04-1995	JP	4215855 A	06-08-1992
EP 277325	A	10-08-1988	CA	1325791 A	04-01-1994
			JP	63166109 A	09-07-1988
			US	4853252 A	01-08-1989
US 3546011	A	08-12-1970	BE	713593 A	16-08-1968
			DE	1615961 A	25-06-1970
			FR	1566836 A	09-05-1969
			GB	1195512 A	17-06-1970
			NL	6804817 A	14-10-1968

DOCKET NO: UAS-FIN-193  
SERIAL NO: \_\_\_\_\_  
APPLICANT: Harry Hedler et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.  
P.O. BOX 2480  
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022  
TEL. (954) 925-1100